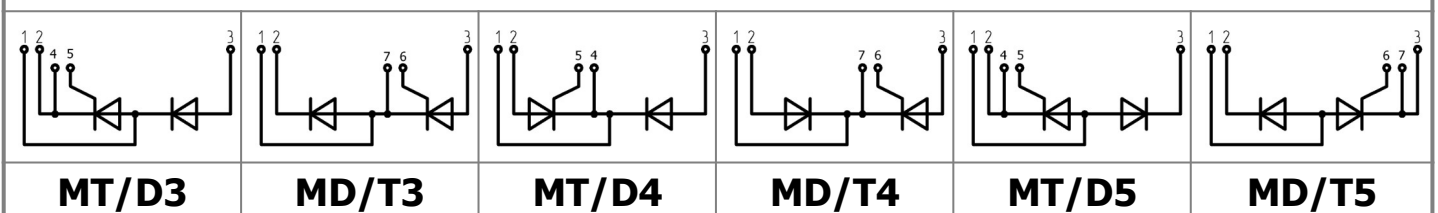
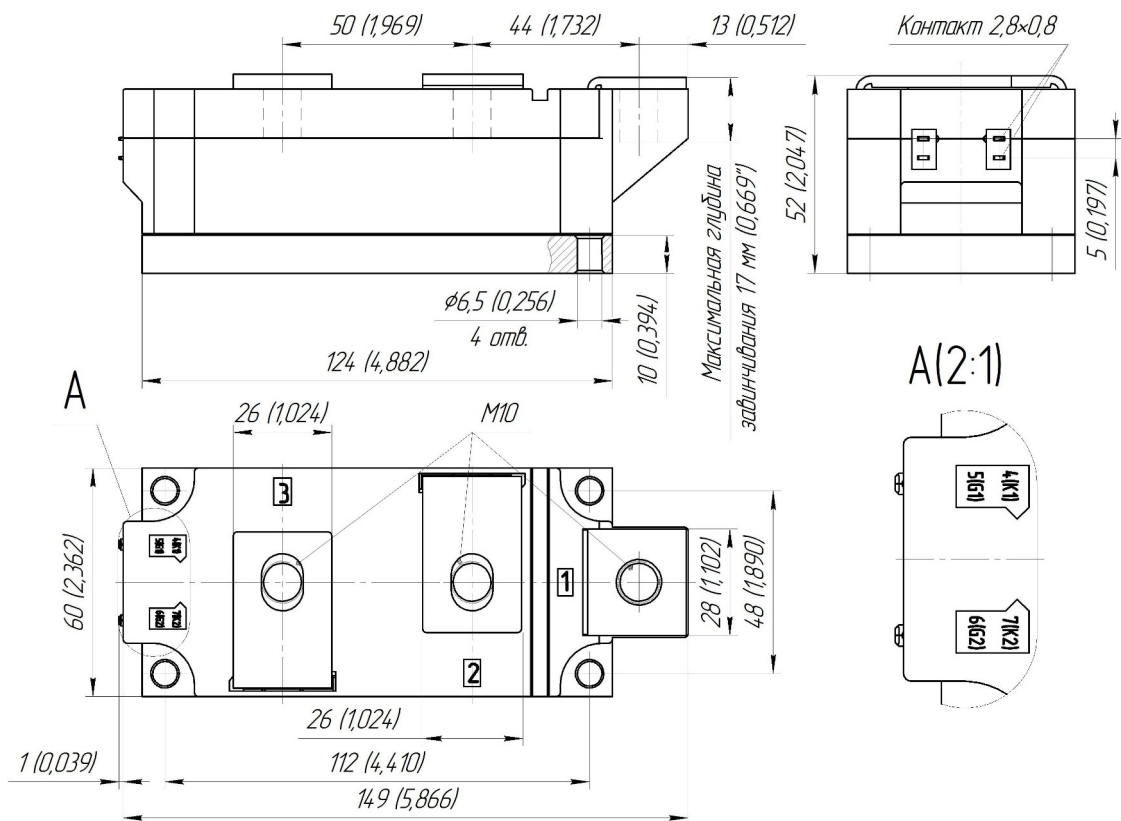
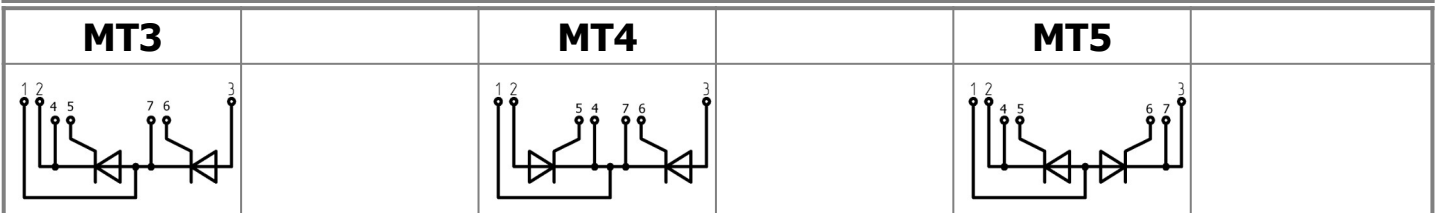




Изолированное основание  
 Корпус промышленного стандарта  
 Упрощенная механическая конструкция,  
 быстрая сборка  
 Прижимная конструкция

## Двухпозиционный Тиристорный Модуль МТх-540-18-А2

Средний прямой ток	$I_{TAV}$		540 А	
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	$U_{DRM}$		1400...1800 В	
Повторяющееся импульсное обратное напряжение	$U_{RRM}$			
Время выключения	$t_q$		160 мкс	
$U_{DRM}, U_{RRM}, В$	1400	1500	1600	1800
Класс по напряжению	14	15	16	18
$T_j, ^\circ C$	-40...+130			



**ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ**

Обозначение и наименование параметра		Ед. изм.	Значение	Условия измерения
<b>Параметры в проводящем состоянии</b>				
$I_{TAV}$	Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии	А	540 581	$T_c = 89\text{ }^\circ\text{C}$ ; $T_c = 85\text{ }^\circ\text{C}$ ; 180 эл. град. синус; 50 Гц
$I_{TRMS}$	Действующий ток в открытом состоянии	А	847	$T_c = 89\text{ }^\circ\text{C}$ ; 180 эл. град. синус; 50 Гц
$I_{TSM}$	Ударный ток в открытом состоянии	кА	16.5 19.0	$T_j = T_{j\max}$ $T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$ 180 эл. град. синус; $t_p = 10\text{ мс}$ ; единичный импульс; $U_D = U_R = 0\text{ В}$ ; Импульс управления: $I_G = 2\text{ А}$ ; $t_{GP} = 50\text{ мкс}$ ; $di_G/dt \geq 1\text{ А/мкс}$
			17.0 20.0	$T_j = T_{j\max}$ $T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$ 180 эл. град. синус; $t_p = 8.3\text{ мс}$ ; единичный импульс; $U_D = U_R = 0\text{ В}$ ; Импульс управления: $I_G = 2\text{ А}$ ; $t_{GP} = 50\text{ мкс}$ ; $di_G/dt \geq 1\text{ А/мкс}$
$I^2t$	Защитный показатель	$A^2c \cdot 10^3$	1300 1800	$T_j = T_{j\max}$ $T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$ 180 эл. град. синус; $t_p = 10\text{ мс}$ ; единичный импульс; $U_D = U_R = 0\text{ В}$ ; Импульс управления: $I_G = 2\text{ А}$ ; $t_{GP} = 50\text{ мкс}$ ; $di_G/dt \geq 1\text{ А/мкс}$
			1100 1600	$T_j = T_{j\max}$ $T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$ 180 эл. град. синус; $t_p = 8.3\text{ мс}$ ; единичный импульс; $U_D = U_R = 0\text{ В}$ ; Импульс управления: $I_G = 2\text{ А}$ ; $t_{GP} = 50\text{ мкс}$ ; $di_G/dt \geq 1\text{ А/мкс}$
<b>Блокирующие параметры</b>				
$U_{DRM}, U_{RRM}$	Повторяющееся импульсное обратное напряжение и повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	В	1400...1800	$T_{j\min} < T_j < T_{j\max}$ ; 180 эл. град. синус; 50 Гц; управление разомкнуто
$U_{DSM}, U_{RSM}$	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение и неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	В	1500...1900	$T_{j\min} < T_j < T_{j\max}$ ; 180 эл. град. синус; единичный импульс; управление разомкнуто
$U_D, U_R$	Постоянное обратное и постоянное прямое напряжение	В	$0.6 \cdot U_{DRM}$ $0.6 \cdot U_{RRM}$	$T_j = T_{j\max}$ ; управление разомкнуто
<b>Параметры управления</b>				
$I_{FGM}$	Максимальный прямой ток управления	А	8	$T_j = T_{j\max}$
$U_{RGM}$	Максимальное обратное напряжение управления	В	5	
$P_G$	Максимальная рассеиваемая мощность по управлению	Вт	4	$T_j = T_{j\max}$ для постоянного тока управления
<b>Параметры переключения</b>				
$(di_T/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии ( $f = 1\text{ Hz}$ )	А/мкс	1250	$T_j = T_{j\max}$ ; $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM}$ ; $I_{TM} = 2000\text{ А}$ ; Импульс управления: $I_G = 2\text{ А}$ ; $t_{GP} = 50\text{ мкс}$ ; $di_G/dt \geq 2\text{ А/мкс}$
<b>Тепловые параметры</b>				
$T_{stg}$	Температура хранения	$^\circ\text{C}$	-40...+50	
$T_j$	Температура р-п перехода	$^\circ\text{C}$	-40...+130	
$T_{c\text{ op}}$	Рабочая температура корпуса	$^\circ\text{C}$	-40...+125	
<b>Механические параметры</b>				
$a$	Ускорение	м/с <sup>2</sup>	50	

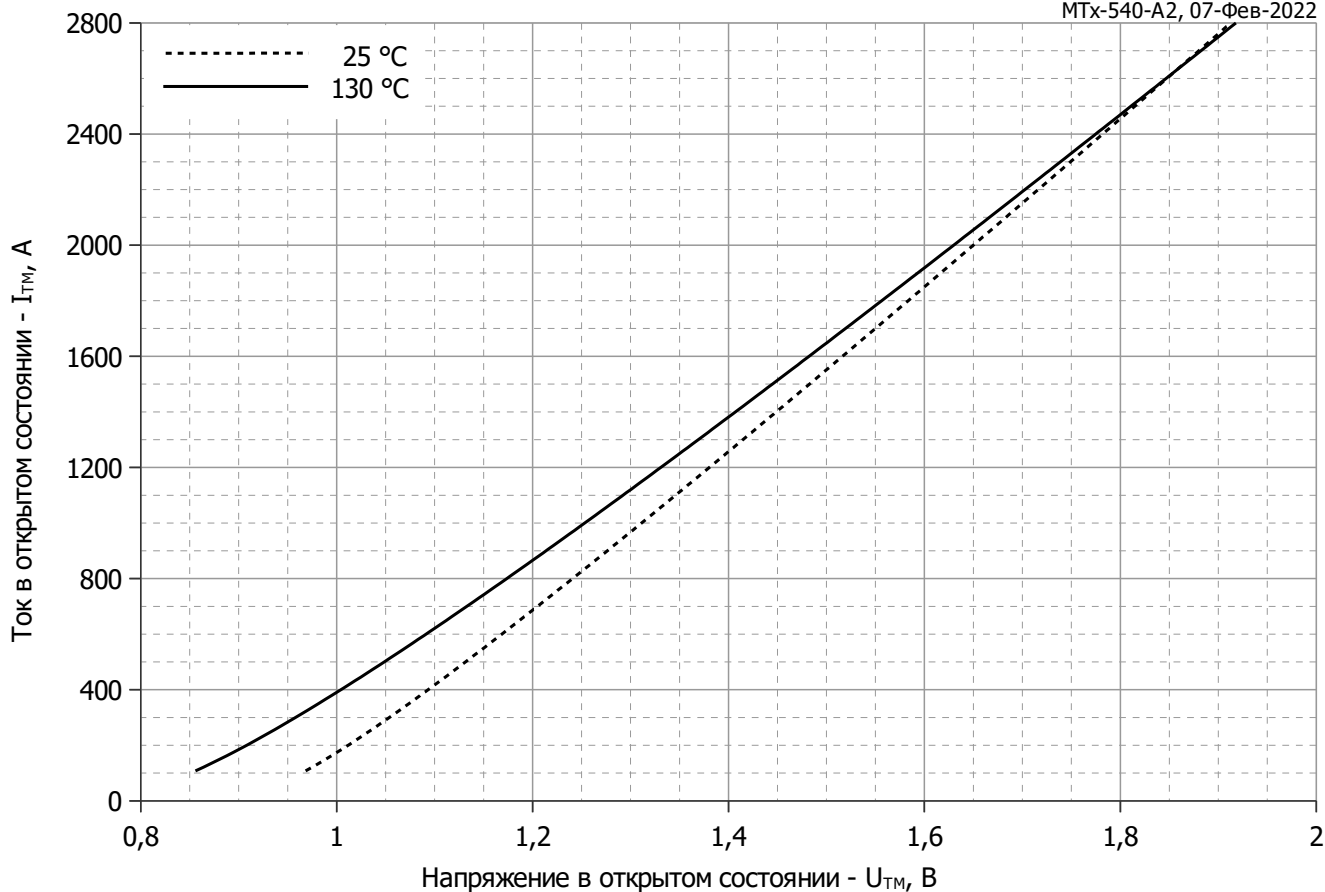
## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение и наименование характеристики		Ед. изм.	Значение	Условия измерения			
<b>Характеристики в проводящем состоянии</b>							
$U_{TM}$	Импульсное напряжение в открытом состоянии, макс	В	1.50	$T_j=25\text{ }^\circ\text{C}; I_{TM}=1570\text{ A}$			
$U_{T(TO)}$	Пороговое напряжение, макс	В	0.876	$T_j=T_{j\text{ max}};$ $0.5 \pi I_{TAV} < I_T < 1.5 \pi I_{TAV}$			
$r_T$	Динамическое сопротивление в открытом состоянии, макс	МОм	0.374				
$I_L$	Ток включения, макс	мА	1000	$T_j=25\text{ }^\circ\text{C}; U_D=12\text{ В};$ Импульс управления: $I_G=2\text{ A};$ $t_{GP}=50\text{ мкс}; di_G/dt \geq 1\text{ А/мкс}$			
$I_H$	Ток удержания, макс	мА	300	$T_j=25\text{ }^\circ\text{C};$ $U_D=12\text{ В};$ управление разомкнуто			
<b>Блокирующие характеристики</b>							
$I_{DRM}, I_{RRM}$	Повторяющийся импульсный обратный ток и повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии, макс	мА	70 3.00	$T_j=T_{j\text{ max}};$ $T_j=25\text{ }^\circ\text{C}$	$U_D=U_{DRM}; U_R=U_{RRM}$		
$(du_D/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии <sup>1)</sup> , мин	В/мкс	200, 320, 500, 1000, 1600, 2000, 2500	$T_j=T_{j\text{ max}};$ $U_D=0.67 \cdot U_{DRM};$ управление разомкнуто			
<b>Характеристики управления</b>							
$U_{GT}$	Отпирающее постоянное напряжение управления, макс	В	3.00 2.50 1.50	$T_j=T_{j\text{ min}};$ $T_j=25\text{ }^\circ\text{C}$ $T_j=T_{j\text{ max}}$	$U_D=12\text{ В}; I_D=3\text{ А};$ Постоянный ток управления		
$I_{GT}$	Отпирающий постоянный ток управления, макс	мА	400 250 150	$T_j=T_{j\text{ min}};$ $T_j=25\text{ }^\circ\text{C}$ $T_j=T_{j\text{ max}}$			
$U_{GD}$	Неотпирающее постоянное напряжение управления, мин	В	0.30	$T_j=T_{j\text{ max}};$ $U_D=0.67 \cdot U_{DRM};$ Постоянный ток управления			
$I_{GD}$	Неотпирающий постоянный ток управления, мин	мА	35.00				
<b>Динамические характеристики</b>							
$t_{gd}$	Время задержки, макс	мкс	0.80	$T_j=25\text{ }^\circ\text{C}; U_D=1000\text{ В}; I_{TM}=I_{TAV};$ $di/dt=200\text{ А/мкс};$			
$t_{gt}$	Время включения, макс	мкс	3.00	Импульс управления: $I_G=2\text{ А}; U_G=20\text{ В};$ $t_{GP}=50\text{ мкс}; di_G/dt=2\text{ А/мкс}$			
$t_q$	Время выключения <sup>2)</sup> , макс	мкс	160	$du_D/dt=50\text{ В/мкс}; T_j=T_{j\text{ max}}; I_{TM}=500\text{ А};$ $di_R/dt=-10\text{ А/мкс}; U_R=100\text{ В};$ $U_D=0.67 \cdot U_{DRM};$			
$Q_{rr}$	Заряд обратного восстановления, макс	мкКл	1690	$T_j=T_{j\text{ max}}; I_{TM}=I_{TAV};$ $di_R/dt=-10\text{ А/мкс};$ $U_R=100\text{ В}$			
$t_{rr}$	Время обратного восстановления, макс	мкс	25				
$I_{rr}$	Обратный ток восстановления, макс	А	135				
<b>Тепловые характеристики</b>							
$R_{thjc}$	Тепловое сопротивление р-п переход-корпус, макс			180 эл. град. синус; 50 Гц			
		на модуль	$^\circ\text{C/Вт}$			0.0275	
		на позицию	$^\circ\text{C/Вт}$			0.0550	
		на модуль	$^\circ\text{C/Вт}$			0.0265	
$R_{thch}$	Тепловое сопротивление корпус-охладитель, макс			Постоянный ток			
			на модуль			$^\circ\text{C/Вт}$	0.0100
			на позицию			$^\circ\text{C/Вт}$	0.0200

Характеристики изоляции					
U <sub>ISOL</sub>	Электрическая прочность изоляции	кВ	3.00	синус; 50 Гц; действующее значение	t=60 с
			3.60		t=1 с
Механические характеристики					
M <sub>1</sub>	Момент затяжки основания (M6) <sup>3)</sup>	Нм	6.00	Допуск ± 15%	
M <sub>2</sub>	Момент затяжки выводов (M10) <sup>3)</sup>	Нм	12.00	Допуск ± 15%	
m	Масса, макс	г	1500		

МАРКИРОВКА								ПРИМЕЧАНИЕ																												
MT	3	-	540	-	18	-	A2	T2	-	A2	-	Y2																								
1	2		3		4		5	6		7		8	<sup>1)</sup> Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии																							
1. Тиристорный модуль (MT) Тиристорно-диодный модуль (MT/Д) Диодно-тиристорный модуль (МД/Т) 2. Схема включения 3. Средний прямой ток, А 4. Класс по напряжению 5. Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии 6. Группа по времени выключения (du <sub>D</sub> /dt=50 В/мкс) 7. Тип корпуса (M.A2) 8. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: Y2													<table border="1"> <thead> <tr> <th>Обозначение группы</th> <th>P2</th> <th>K2</th> <th>E2</th> <th>A2</th> <th>T1</th> <th>P1</th> <th>M1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(du<sub>D</sub>/dt)<sub>crit</sub>, В/мкс</td> <td>200</td> <td>320</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>1600</td> <td>2000</td> <td>2500</td> </tr> </tbody> </table>								Обозначение группы	P2	K2	E2	A2	T1	P1	M1	(du <sub>D</sub> /dt) <sub>crit</sub> , В/мкс	200	320	500	1000	1600	2000	2500
Обозначение группы	P2	K2	E2	A2	T1	P1	M1																													
(du <sub>D</sub> /dt) <sub>crit</sub> , В/мкс	200	320	500	1000	1600	2000	2500																													
													<sup>2)</sup> Время выключения (du <sub>D</sub> /dt=50 В/мкс)																							
													<table border="1"> <thead> <tr> <th>Обозначение группы</th> <th>T2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>t<sub>r</sub>, мкс</td> <td>160</td> </tr> </tbody> </table>								Обозначение группы	T2	t <sub>r</sub> , мкс	160												
Обозначение группы	T2																																			
t <sub>r</sub> , мкс	160																																			
													<sup>3)</sup> Резьба должна быть смазана																							
													Сертифицирован UL, файл № E255404																							

Содержащаяся здесь информация является конфиденциальной и находится под защитой авторских прав. В интересах улучшения качества продукции, АО «Протон-Электротекс» оставляет за собой право изменять информационные листы без уведомления.



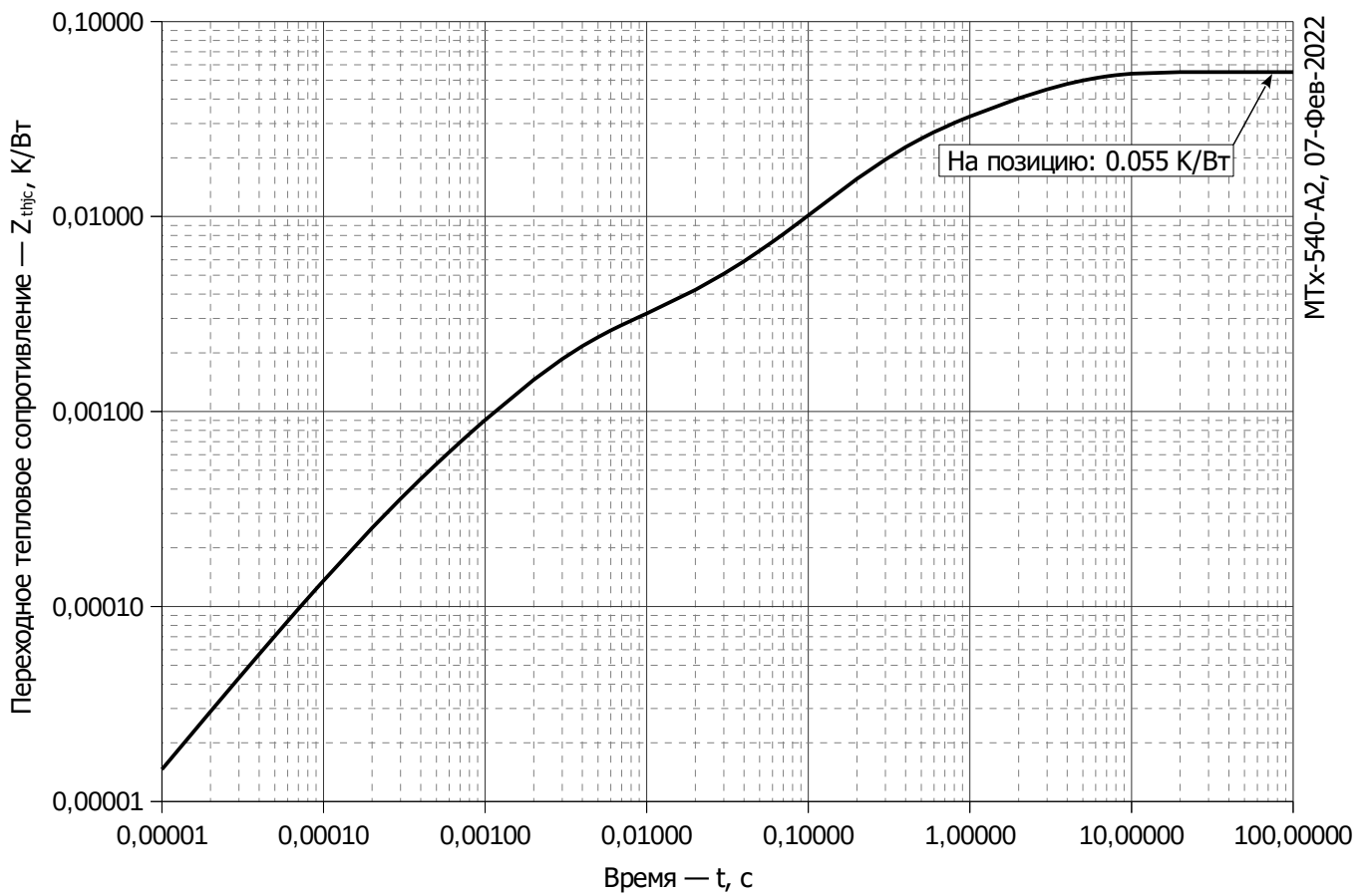
**Рис. 1 – Предельная вольт – амперная характеристика**

Аналитическая функция предельной вольт — амперной характеристики:

$$V_T = A + B \cdot i_T + C \cdot \ln(i_T + 1) + D \cdot \sqrt{i_T}$$

	Коэффициенты для графика	
	T <sub>j</sub> = 25°C	T <sub>j</sub> = T <sub>j max</sub>
<b>A</b>	0.86113373	0.72791860
<b>B</b>	0.00029818	0.00030662
<b>C</b>	0.01035208	0.00948342
<b>D</b>	0.00254320	0.00484336

**Модель предельной вольт – амперной характеристики (см. Рис. 1)**



**Рис. 2 – Зависимость переходного теплового сопротивления  $Z_{thjc}$  от времени  $t$**

Аналитическая зависимость переходного теплового сопротивления переход — корпус:

$$Z_{thjc} = \sum_{i=1}^n R_i \left( 1 - e^{-\frac{t}{\tau_i}} \right)$$

Где  $i = 1$  to  $n$ ,  $n$  – число суммирующихся элементов.

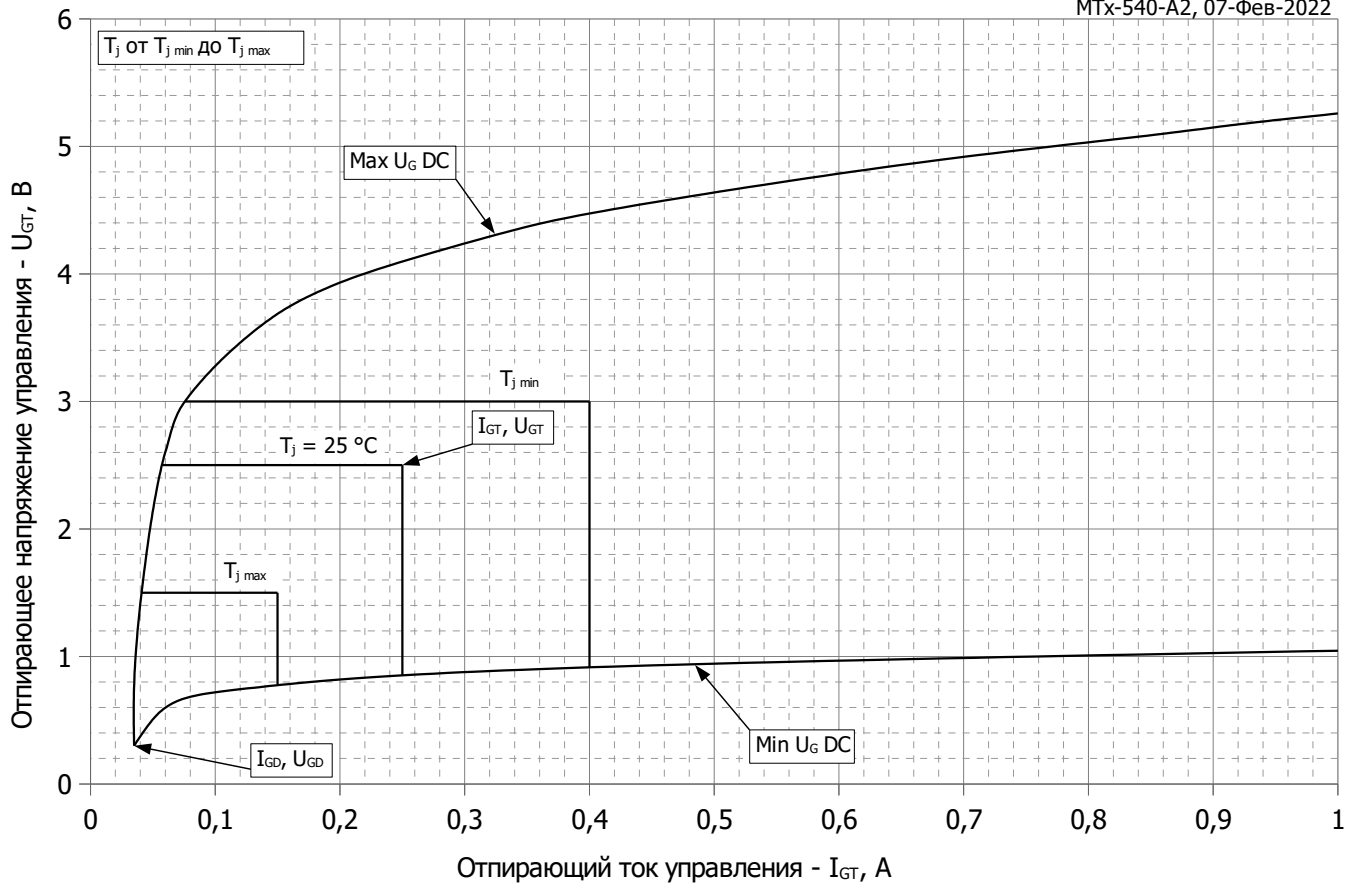
$t$  = продолжительность импульсного нагрева в секундах.

$Z_{thjc}$  = Тепловое сопротивление за время  $t$ .

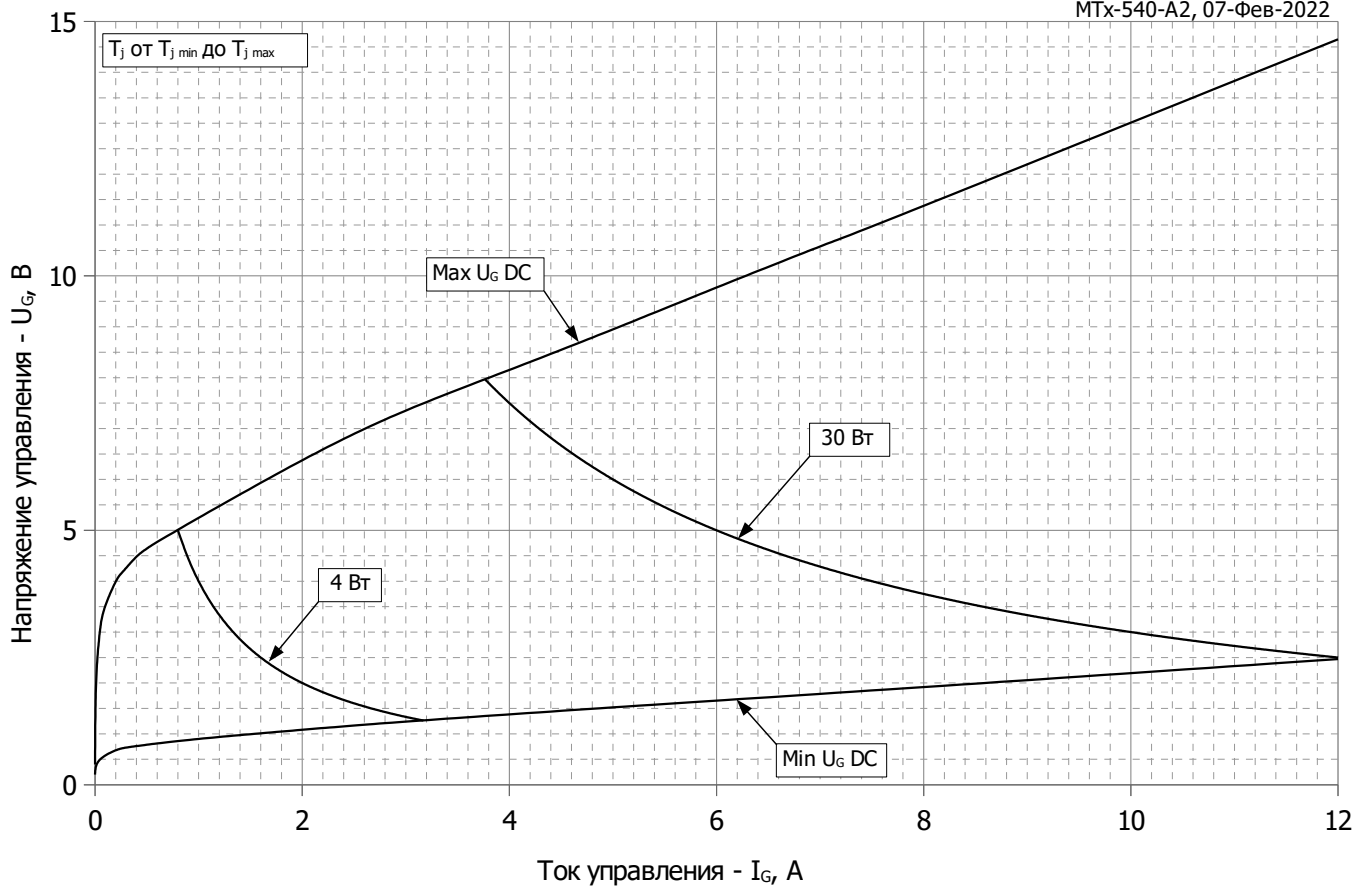
$R_i, \tau_i$  = расчетные коэффициенты, приведенные в таблице.

$i$	1	2	3	4	5	6
$R_i, \text{K/Wt}$	0.0249	0.0112	0.01635	0.0006528	0.001791	0.0001363
$\tau_{ij}, \text{c}$	3.132	1.000	0.2335	0.01038	0.002348	0.0002448

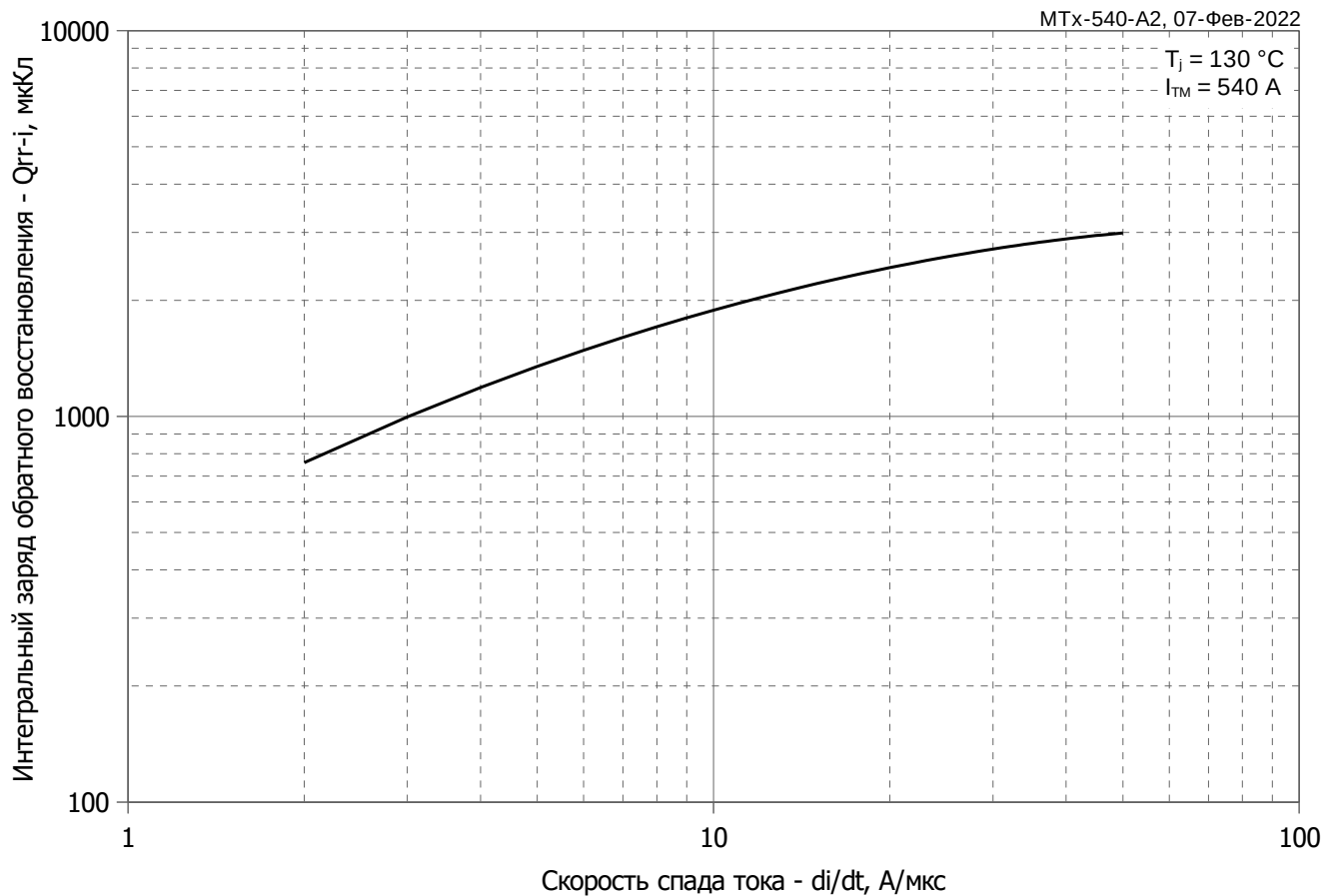
**Модель переходного теплового сопротивления переход - корпус (см. Рис. 2)**



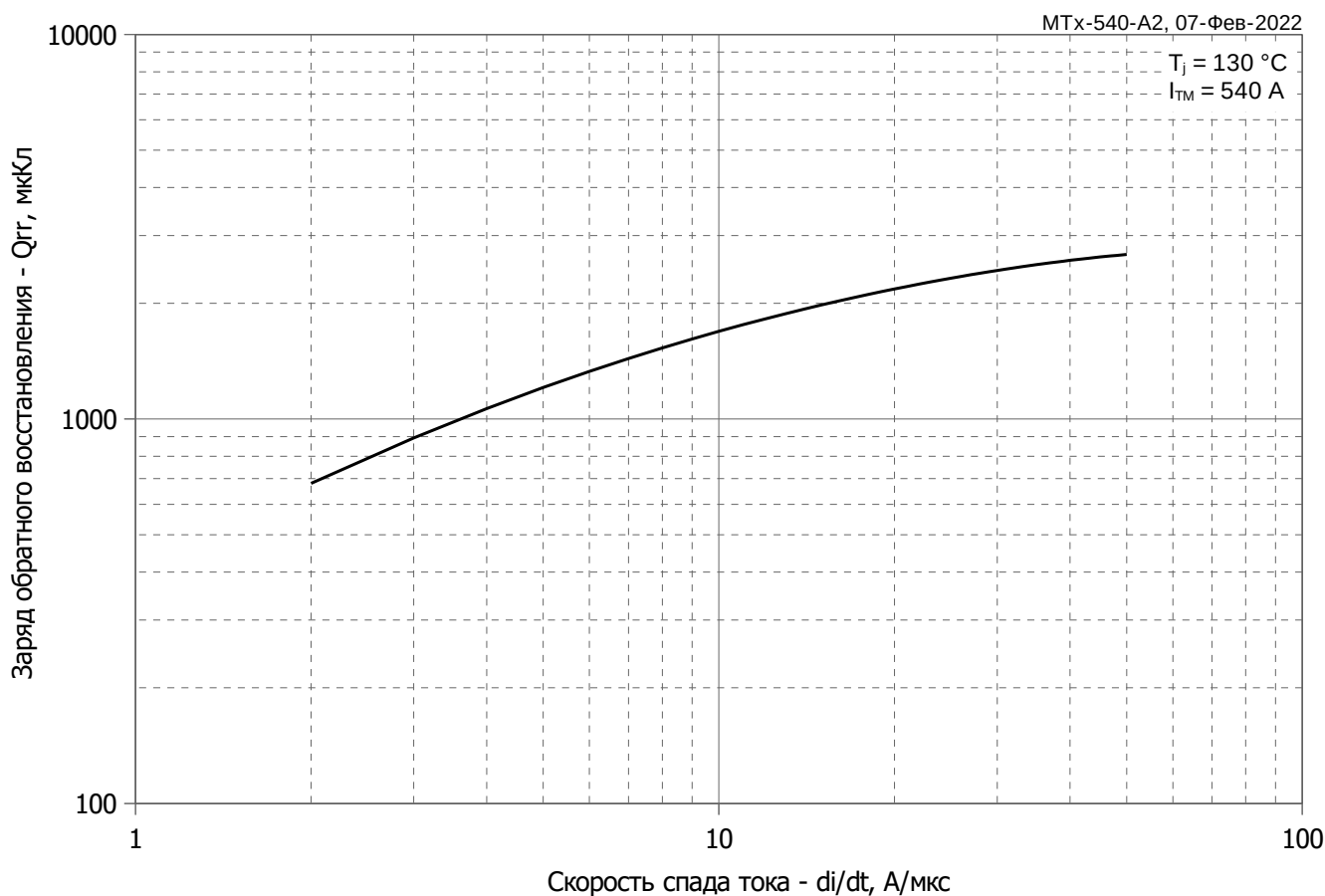
**Рис. 3 – Вольт – амперная характеристика цепи управления**



**Рис. 4 – Вольт – амперная характеристика цепи управления – Кривые мощности**

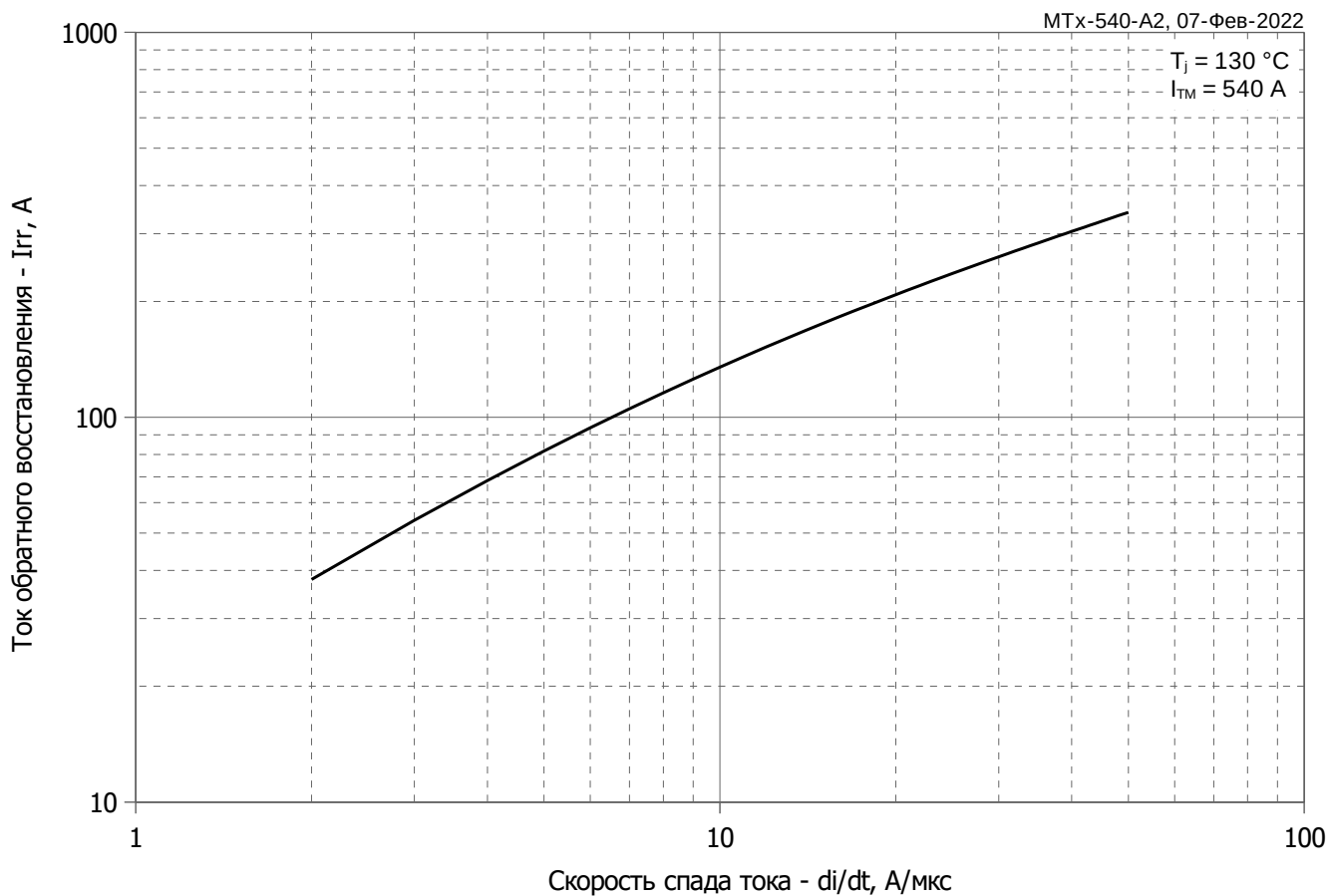


**Рис. 5 – Зависимость максимального интегрального заряда обратного восстановления  $Q_{rr-i}$  от скорости спада тока  $di_R/dt$  в открытом состоянии**

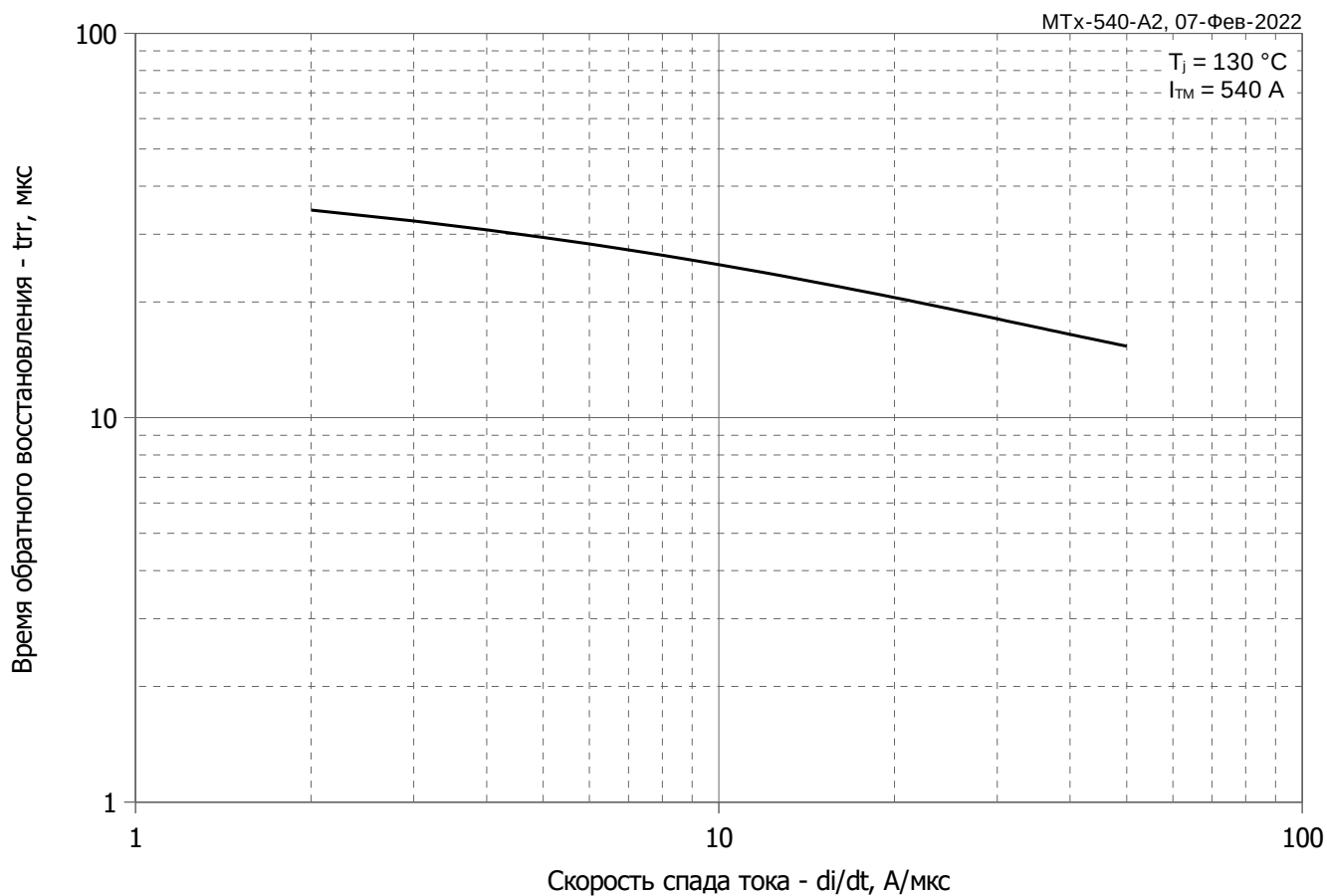


**Рис. 6 – Зависимость максимального заряда обратного восстановления  $Q_{rr}$  от скорости спада тока  $di_R/dt$  (по ГОСТ 24461, хорда 25%) в открытом состоянии**

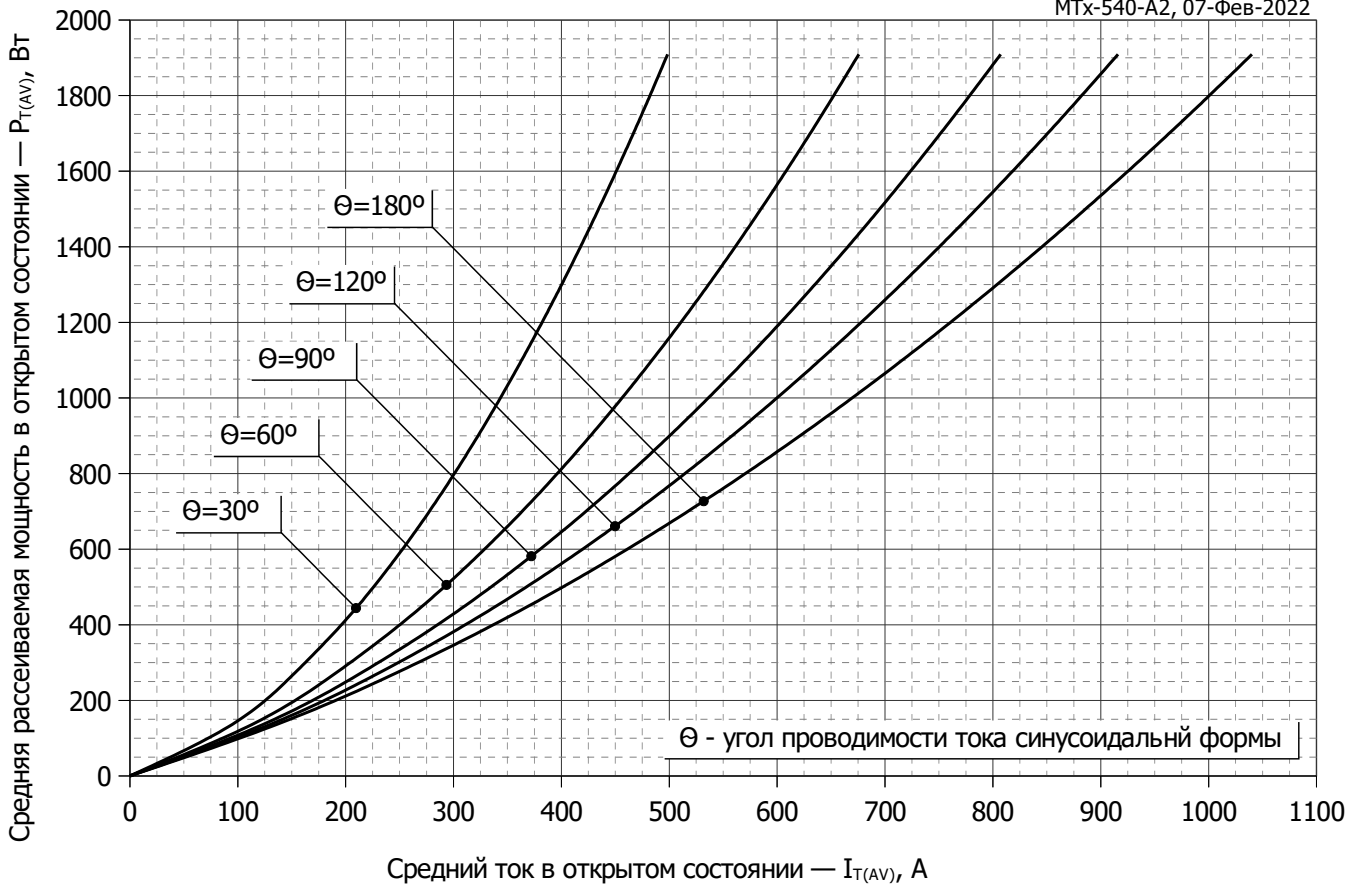




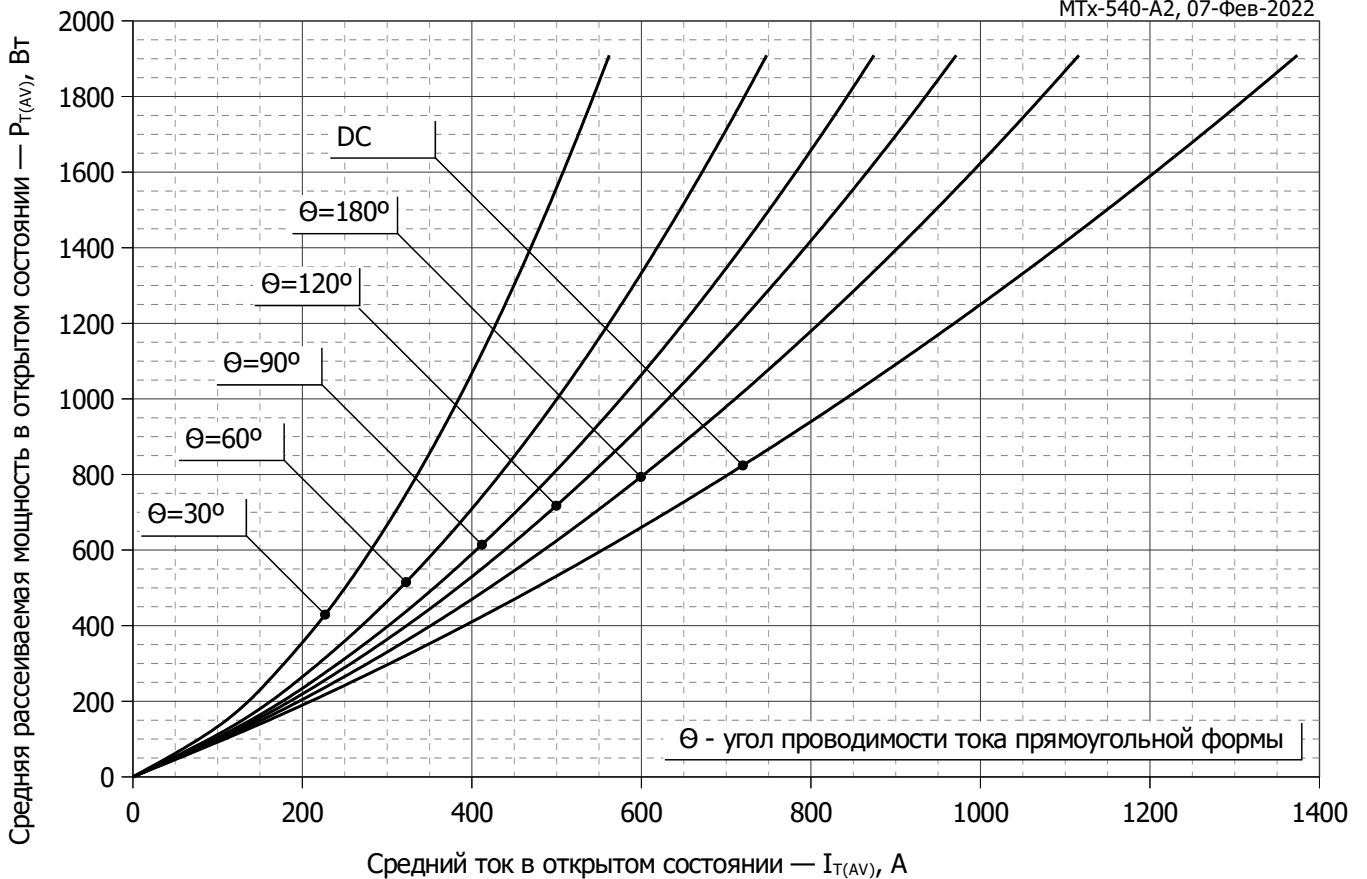
**Рис. 7 – Зависимость максимального обратного тока восстановления  $I_{rr}$  от скорости спада тока  $di_R/dt$  в открытом состоянии**



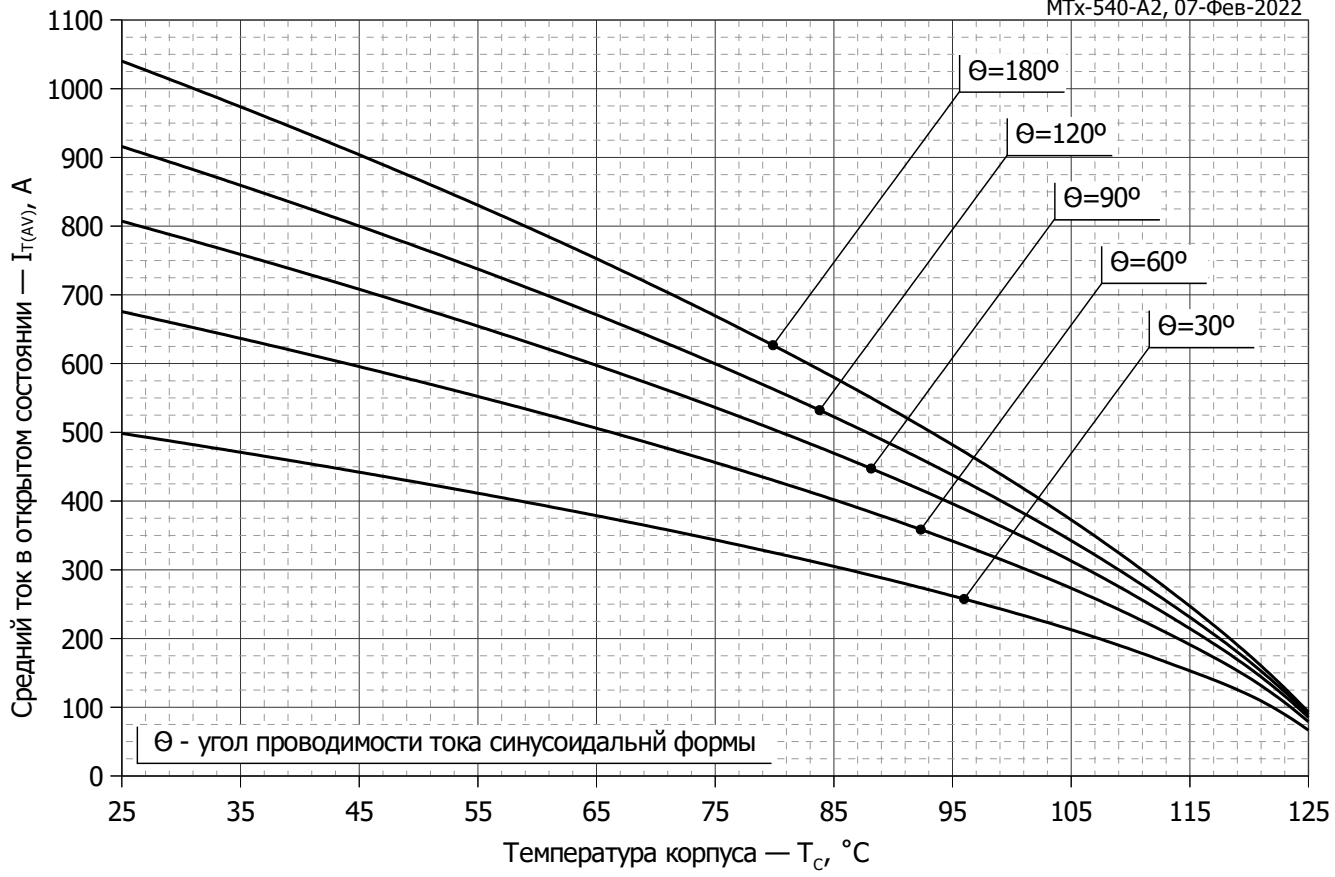
**Рис. 8 - Зависимость максимального времени обратного восстановления  $t_{rr}$  от скорости спада тока  $di_R/dt$  (по ГОСТ 24461, хорда 25%) в открытом состоянии**



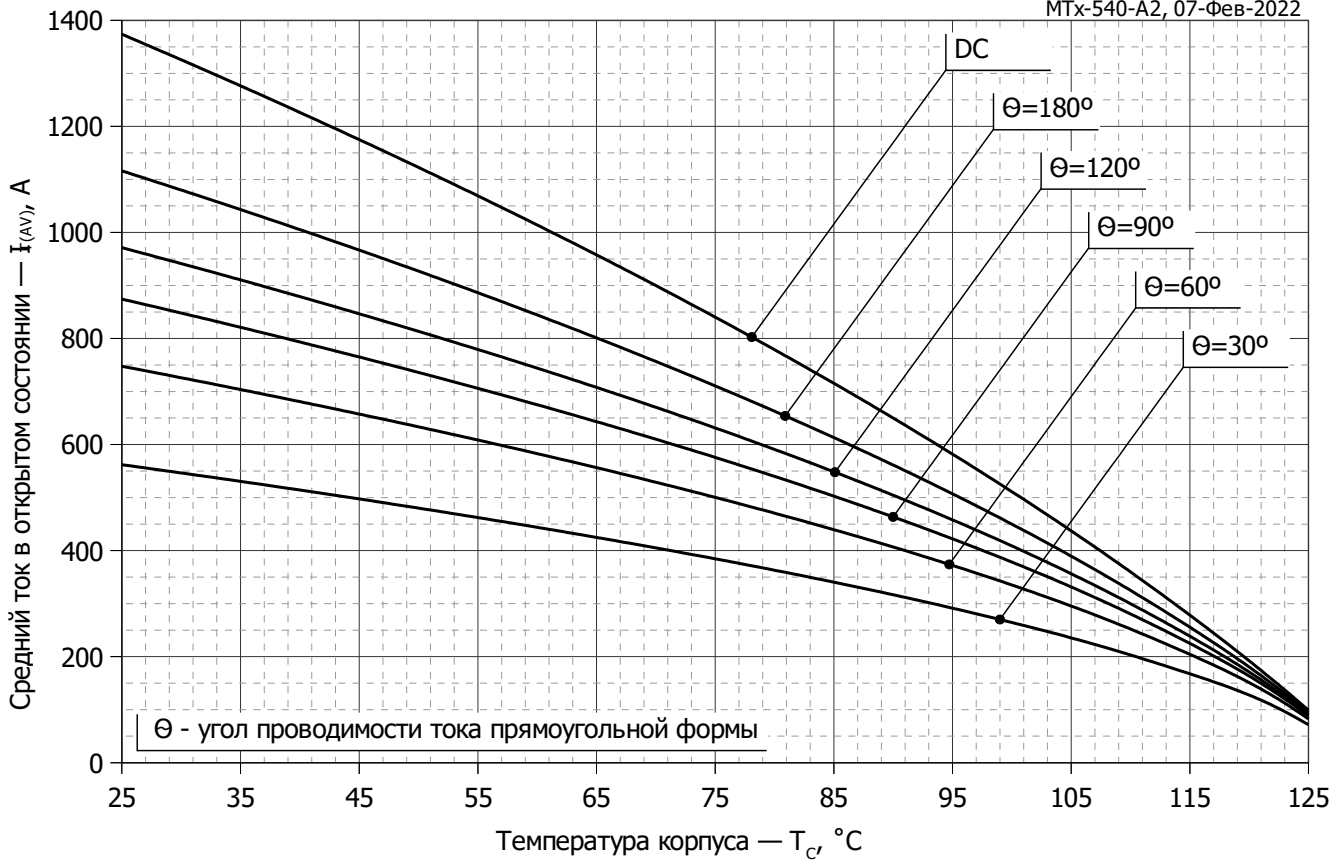
**Рис. 9 - Зависимость потерь мощности  $P_{TAV}$  от среднего тока в открытом состоянии  $I_{TAV}$  синусоидальной формы при различных углах проводимости ( $f=50$  Гц)**



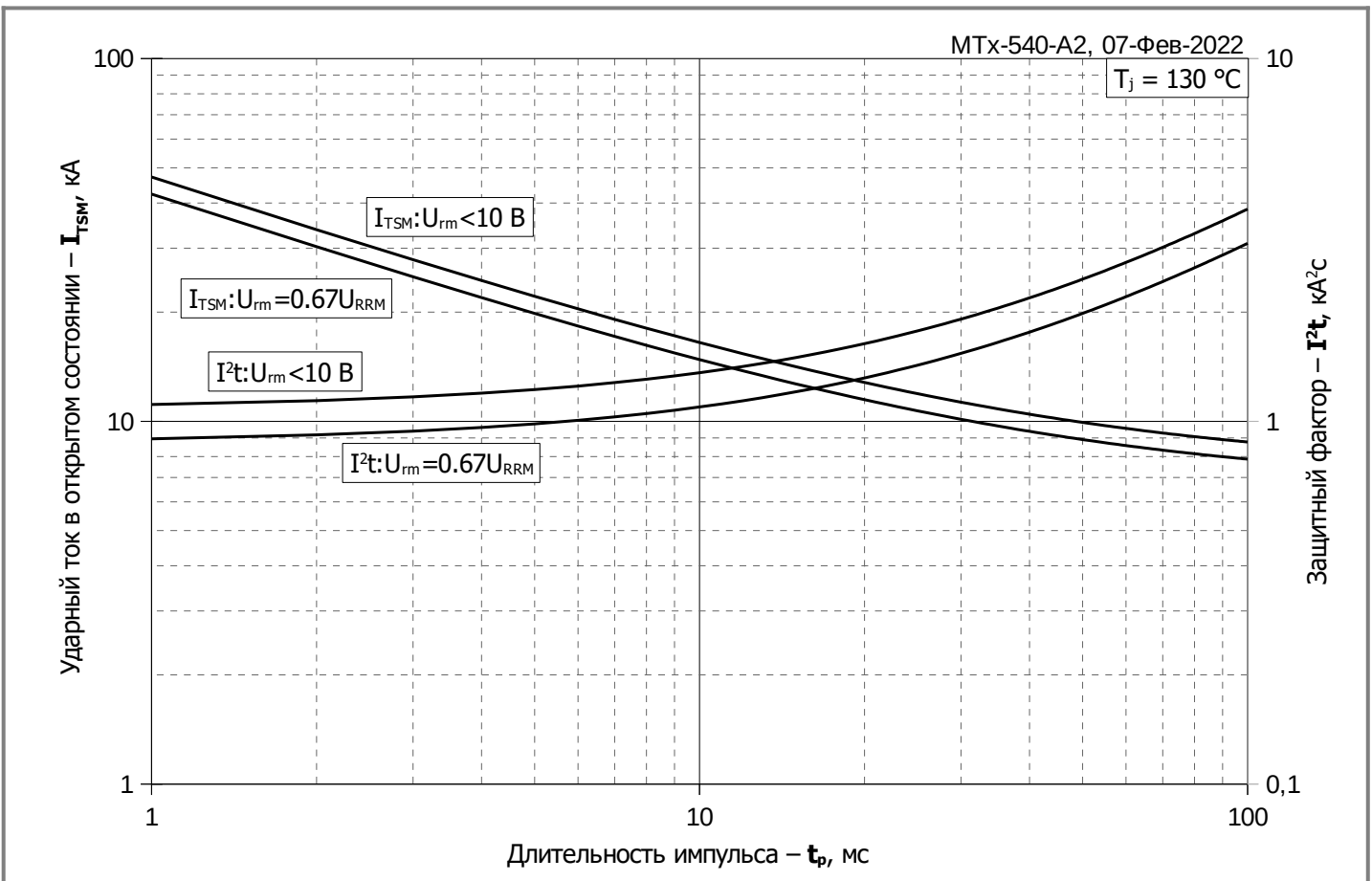
**Рис. 10 – Зависимость потерь мощности  $P_{TAV}$  от среднего тока в открытом состоянии  $I_{TAV}$  прямоугольной формы при различных углах проводимости ( $f=50$  Гц)**



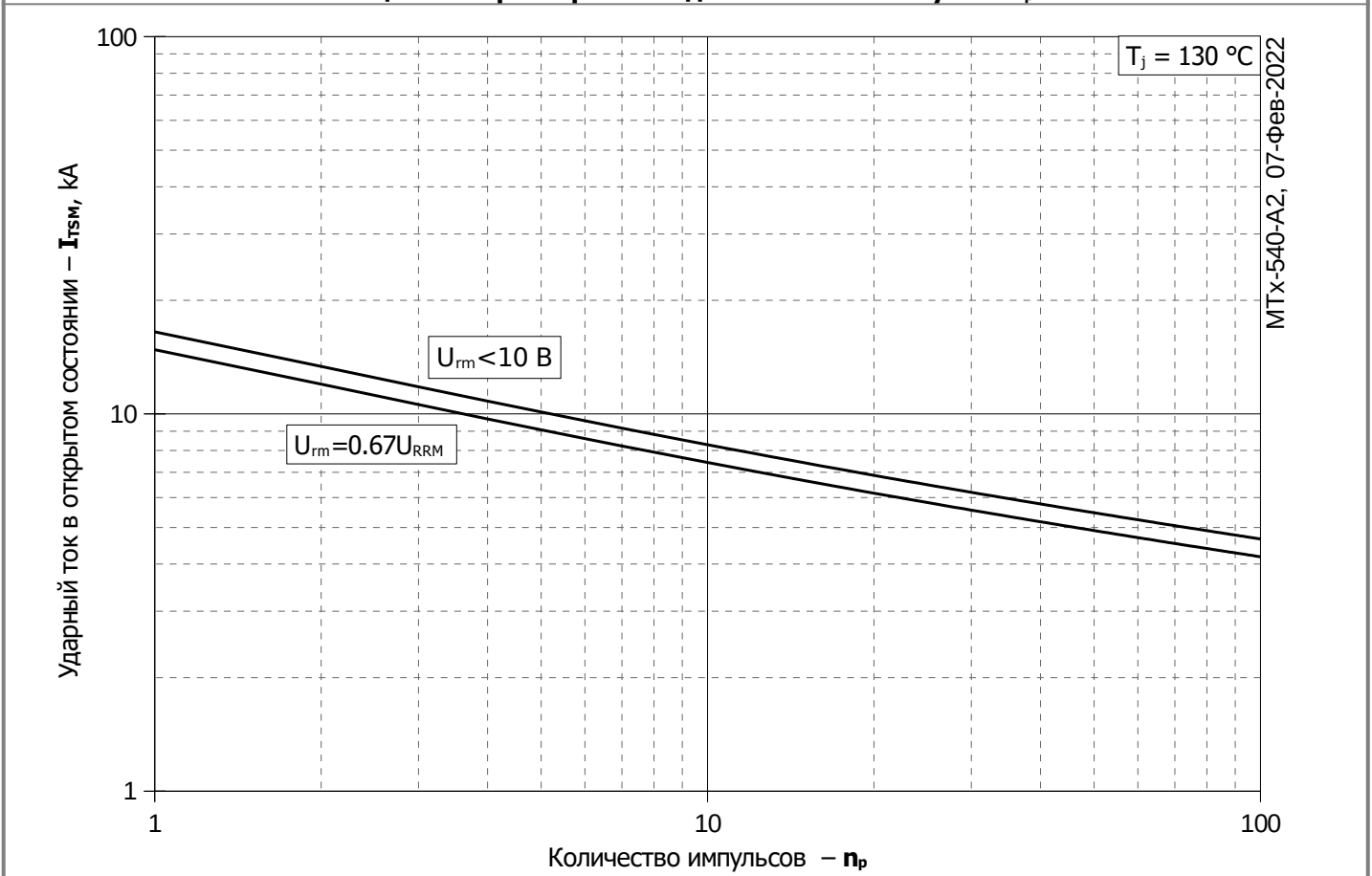
**Рис. 11 – Зависимость среднего тока в открытом состоянии  $I_{TAV}$  от температуры корпуса  $T_C$  для синусоидальной формы тока при различных углах проводимости ( $f=50$  Гц)**



**Рис. 12 - Зависимость среднего тока в открытом состоянии  $I_{TAV}$  от температуры корпуса  $T_C$  для прямоугольной формы тока при различных углах проводимости ( $f=50$  Гц)**



**Рис. 13 – Зависимость максимальной амплитуды ударного тока в открытом состоянии  $I_{TSM}$  и защитного фактора  $I^2t$  от длительности импульса  $t_p$**



**Рис. 14 – Зависимость максимальной амплитуды ударного тока в открытом состоянии  $I_{TSM}$  от количества импульсов  $n_p$**